

Спосіб отримання напівпровідникових штучних підкладок, що включає отримання на поверхні напівпровідникової підкладки спочатку проміжного напівпровідникового шару, в якому відбувається релаксація пружних напружень невідповідності, а потім вирощування на ньому малодефектного напівпровідникового шару, відмінного за параметром ґратки і хімічного складу від напівпровідникової підкладки, в одному технологічному процесі, який **відрізняється** тим, що проміжний напівпровідниковий шар отримують з того самого матеріалу, що і малодефектний напівпровідниковий шар, та він є комірковим шаром.